

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

3-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

H.M.Abdunazarov, M.H.Umarova Surxondaryo viloyati o'simliklar olamining geografik tarqalishi.....	272
A.K.Ergashev Avstraliya materigi yer usti suvlari tarqalishining hududiy xususiyatlari (daryolar misolida).....	277
R.T.Pirnazarov, S.I.Ussonova O'zbekiston va unga tutash tog'li hududlardagi to'g'onli ko'llar, ularning tadqiq etilishi va ular bilan bog'liq muammolarning keskinlashuvi.....	282

ILMIY AXBOROT

D.I.Ibragimova Isajon Sultonning tarixiy hikoyalarida mavzu va g'oya.....	290
Sh.A.Yuldashev, S.Muhammadjonova Optoelektronikada qo'llash uchun optronlar yaratish.....	293
A.A.Ergashev Nota muharriri finale-2003 ning amaliyotda qo'llanishi.....	298
I.Rustamov Yangi O'zbekistonda yaratilayotgan doira darsliklari va ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi roli.....	302
M.Nasritdinova Yangi O'zbekiston yoshlarining ma'naviy-axloqiy-estetik dunyoqarashini yuksaltirishda musiqa san'atining o'рни.....	306
M.V.Nasridinov Ingliz va o'zbek tillarida "Maqsad" konseptining morfologik sathlararo verbalizatorlari struktural-semantik turlari maydoni.....	310
G.O.Shaxbazova Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash tizimini modernizatsiyalashning ijtimoiy-pedagogik zarurati.....	315
N.N.Norxo'jayeva Oliy texnik ta'lim muassasalari talabalarining kreativ-grafik kompetentligini rivojlantirish komponentlari va kriteriyalarining pedagogik mazmuni.....	318
D.R.Ismoilova Ingliz va o'zbek tillaridagi "Jinoyat" semantik maydoni.....	322
D.B.Toshpo'latova Malakaviy amaliyot vositasida talabalarni amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlashga innovatsion yondashuv.....	326
М.Ф.Рахмоналиева Медиаобразование и медиакомпетентность в современном социокультурном контексте в преподавании английского языка для студентов технического института.....	332
M.F.Adasheva Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy o'z-o'zini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	336
U.Q.Maqsudov, M.O.Yuldasheva O'qish savodxonligining asosiy tushunchalari va bolalar rivojlanishidagi roli.....	340
M.A.Abdujalilova Brief theoretical and historical roots of lingo-culture science. Lingo-cultural brief analysis of household items lexemes.....	348
U.T.Isakov O'zbek musiqa madaniyatini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari.....	351
U.U.Xolova Abu Ali Ibn Sino va tasavvuf.....	356
T.Q.Jabborxonov, F.Sh.G'aprov, A.F.Raxmataliyev, Z.O.Yusupov O'rta Osiyoda tarqalgan Inula L. Turkumiga mansub turlarning ekologik mintaqalarda tarqalish tahlillari.....	360
Y.Y.Turakulov Pedagoglar kasbiy faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari.....	366



UO'K: 537.312.62

OPTOELEKTRONIKADA QO'LLASH UCHUN OPTRONLAR YARATISH
СОЗДАНИЕ ОПТРОНИКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПТОЭЛЕКТРОНИКЕ
CREATION OF OPTRONICS FOR APPLICATION IN OPTOELECTRONICS

Yuldashev Shohjahon Abrorovich¹ ¹Farg'ona davlat universiteti, t.f.b.f.d (PhD)**Muhammadjonova Saidxonning²** ²Farg'ona davlat universiteti, talaba**Annotatsiya**

Polikristall yupqa birjinsli emas yarimo'tkazgich pardalardan foydalanib mikroelektronika uchun yuqori samarador optronlar yaratishning fizika, texnikaviy asoslari bayon qilingan. Optron elementlarida kuzatiladigan energetik yo'qotishlarni kamaytirishning ilmiy asoslari tahlil qilingan. Optoelektron qurilmaning samaradorligi yuqoridagilar bilan bir qatorda, elementar optron elementlari, yorug'lik manbasi va uning iste'molchisi orasidagi optik foton vositasidagi bog'lanishlardagi yorug'lik signallarining kam yo'qotishlar bilan buzilmay foto qabul qilgichga yetib kelishi bilan bog'liq. Mikroelektron tizimda ham bu muammoni tolali optika vositasida amalga oshirish mumkin. Tolali optika qurilmalari ixcham, uning yorug'lik tolasidagi diametri 1 mkm atrofida bo'ladi. Elastikligi yuqori, uning egilishi uzatilayotgan optik signalni buzmaydi. Samaradorligi elektr aloqa vositasidan juda yuqori. Tasvir uzatish imkoniyatining darajasi yuqori. Bu afzalliklarni amalga oshirish uchun optik tola bilan manba va yorug'lik iste'molchisi orasidagi optik kontakt sifati yuqori bo'lishi kerak. Bu vazifani qoniqarli darajada amalga oshirish uchun immersion muxit sifatida sindirish ko'rsatkichi n yorug'lik manbasi va foto qabul qilgich sindirish ko'rsatkichiga yaqin qilib olingan.

Аннотация

Описаны физические и технические основы создания высокоэффективных оптронов для микроэлектроники с использованием поликристаллических неоднородных полупроводниковых мембран. Проанализированы научные основы снижения энергетических потерь, наблюдаемых в оптронных элементах. Помимо вышесказанного, эффективность оптоэлектронного устройства зависит от того, что световые сигналы доходят до фотоприемника в целостности и с небольшими потерями в оптических фотонно-опосредованных связях между элементарными оптронными элементами, источником света и его потребителем. В микроэлектронной системе эту проблему можно решить с помощью оптоволокон. Волоконно-оптическое устройство компактно, диаметр их световода составляет около 1 мкм. Высокая эластичность, изгиб не разрушает передаваемый оптический сигнал. КПД гораздо выше, чем у электрической связи. Уровень возможности передачи изображений высок. Для реализации этих преимуществ качество оптического контакта между оптическим волокном и источником света и потребителем должно быть высоким. Для удовлетворительного выполнения этой задачи показатель преломления n иммерсионной среды выбирают близким к показателю преломления источника света и фоторецептора.

Abstract

The physical and technical foundations for creating high-performance optocouplers for microelectronics using polycrystalline inhomogeneous semiconductor membranes are described. The scientific basis for reducing energy losses observed in optocouplers is analyzed. In addition to the above, the efficiency of the optoelectronic device depends on the fact that the light signals reach the photo receiver intact with low losses in the optical photon-mediated connections between the elementary optron elements, the light source and its consumer. In a microelectronic system, this problem can be solved by means of fiber optics. Fiber optic devices are compact, their light fiber diameter is about 1 μm . High elasticity, its bending does not destroy the transmitted optical signal. The efficiency is much higher than that of electrical communication. The level of image transfer capability is high. To realize these advantages, the quality of the optical contact between the optical fiber and the light source and consumer must be high. To satisfactorily perform this task, the refractive index (n) of the immersion medium is taken to be close to the refractive index of the light source and the photoreceptor.

Kalit so'zlar: Elementar optron, spektr, yorug'lik diodi, nurlanish amplitudasi, fopriemnik, xalkogenidlar, immersion muxit, optik tola, sindirish ko'rsatkichi, to'la ichki qaytish, potensial zona diagramma.

Ключевые слова: Элементарный оптрон, спектр, светодиод, амплитуда излучения, фото пир, иммерсионная среда, оптическое волокно, показатель преломления, полный внутренний возврат, зонная диаграмма потенциала.

Key words: Elementary optocoupler, spectrum, radiation amplitude, photopire, chalcogenides, immersion medium, optical fiber, refractive index, total internal return, potential band diagram.

KIRISH

Optoelektronika sohasidagi tadqiqotlar natijalaridan zamonaviy fan va texnikaning turli yo'nalishlarida foydalaniladi. Mikroelektronikaning istiqboli uning ajralmas qismi bo'lgan optoelektronika bilan bog'liq. Optoelektronikaning asosiy elementi bu elementar optronlar. Optronni shakllantirish uchun yorug'lik manbasi, yorug'likni qabul qiluvchi tizim (foto qabul qilgich) va manbani foto qabul qilgich bilan foton vositasida bog'lovchi qismlar kerak. Mikroelektronika rivoji uchun optron qismlarining yuqori energiyatejamkor, samarador va ixcham (mitti, mikrominiatyur) elementlar bilan ta'minlanishi muhimdir. Bu muammoni hal qilishda optron qismlarini yupqa yarimo'tkazgich pardalaridan foydalanib tayyorlash yuqori samara beradi. Ularning geometrik o'lchamlarini millionlar darajasida kamaytirish bilan bir qatorda, yarimo'tkazgich yupqa pardalarida kuzatiladigan yangi fotoelektrik hodisalardan foydalanib funksional imkoniyatlari juda yuqori optronlar oilasini yaratish imkoniyati tug'iladi. Shu sababli mikroelektron yupqa pardali optoelektronika sohasining shakllanish tarixi yorug'lik manbai va foto qabul qilgichlar yaratish bilan bog'liq.

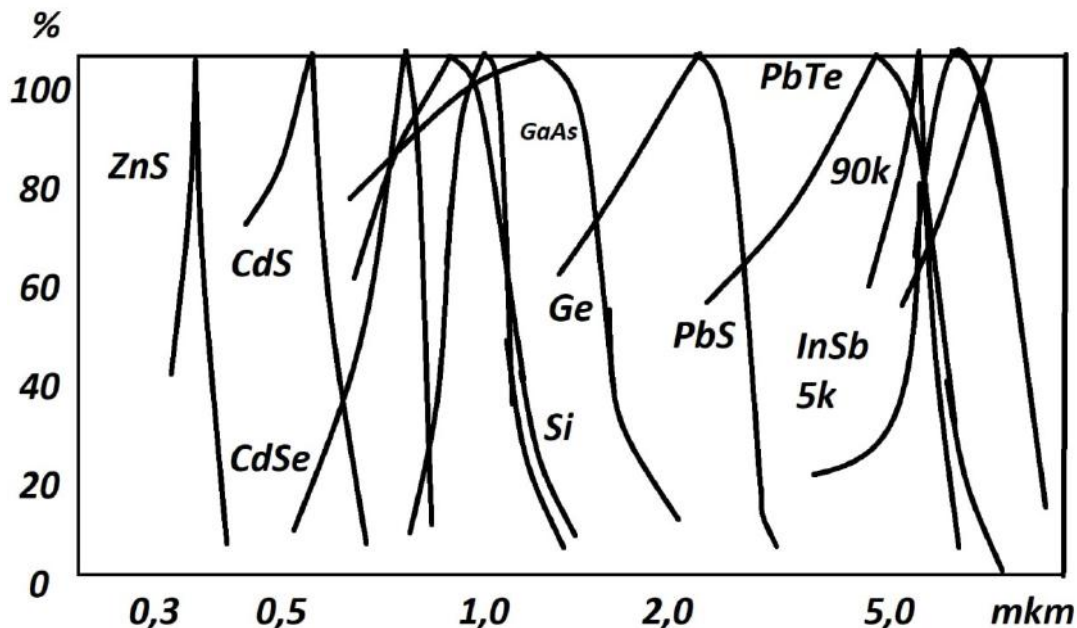
ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Optronlarning samaradorligi asosan uning foton manbasi uzatayotgan yorug'lik energiyasidagi, uzatish tizimidagi, foton qabul qiluvchi qismidagi spektral moslashuvning yuqoriligini ta'minlash bilan bog'liq [1]. Shu bilan birga fotopriemnik materialidagi rekombinatsion jarayonlarda kuzatiladigan energiya yo'qotishlari ham samaradorlikka ta'sir qiladi. Qayd etilgan energiya yo'qotishlarini kamaytirish maqsadida, fotopriemnik va unga yorug'likni eltuvchi tizimga bog'liq spektral, polyarizatsion tadqiqotlar olib borilgan. Bu ilmiy-tadqiqotlar natijalari spektral bog'lanishlarda (Rasm 1) ifoda etilgan.

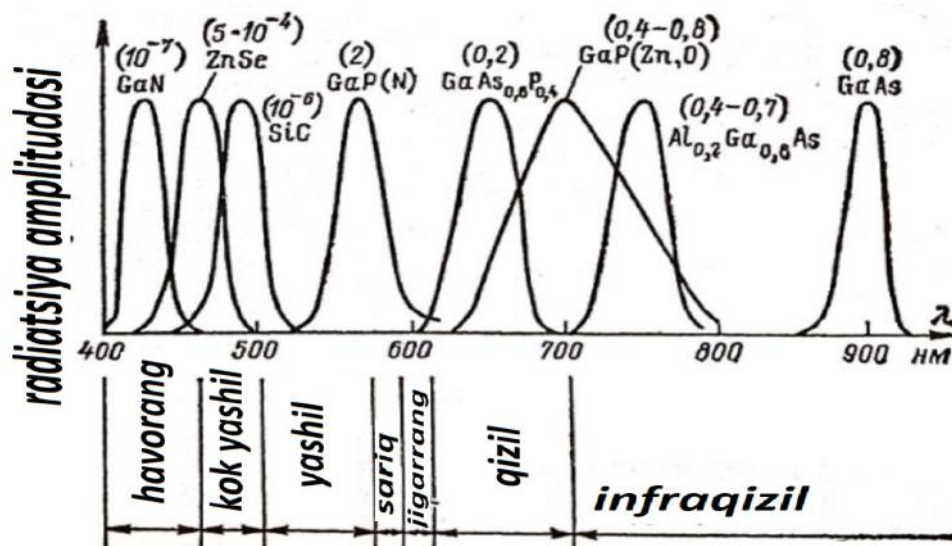
Samaradorlikning spektral bog'lanishiga muvofiq, spektrning ultrabinafsha sohasi uchun (300-400 nm) ZnS dan, spektrning ko'rinadigan nurlar spektral sohasi uchun (400-750 nm) CdTe CdS lardan, infraqizil soha uchun (750-6000 nm) PbS PbSe yarimo'tkazgich materiallarida fotopriyomniklar tayyorlanadi.[2].

Optoelektron quyosh qurilmalari optik (foton) bog'lanishli ikkita kontur elektron bog'lanishli yana ikkita konturdan iborat optoelektron tizim vositasida ishlaydi. Bunday qurilmalarning samaradorligi sifati asosan kontur elementlari bilan bog'liq. Qurilma optronlari elementlarining yorug'lik (foton) manbalarining spektral tarkibi, foton iste'molchilarining (fotopriemnik) spektral tarkiblarining qanchalik mos kelishiga qarab tanlanadi. Moslik darajasiga bog'liq ravishda energiya yo'qotishlari (yorug'lik intensivligiga, spektriga, materialdagi rekombinatsiya-generatsiya bilan bog'liq yo'qotishlar) baholanib boriladi.

ILMIY AXBOROT



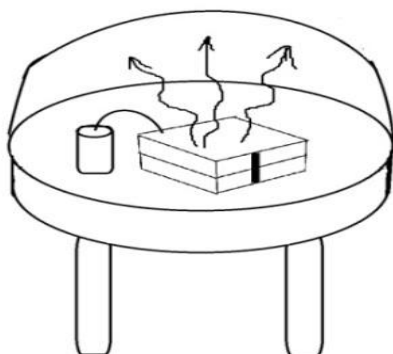
1 – Rasm ilmiy-tadqiqotlar natijalarining spektral bog‘lanishlari



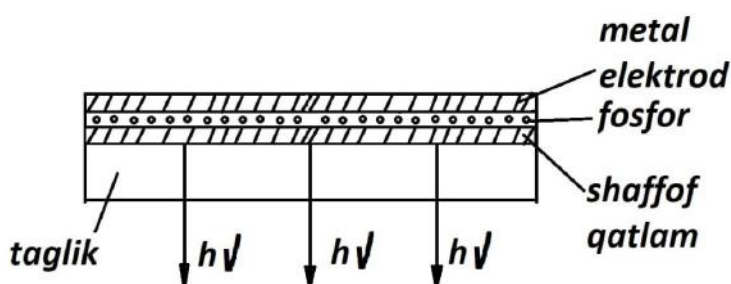
2-rasm yorug‘lik diodlari uchun nurlanish amplitudasining spektri

Buning uchun optojuftlik elementlarida spektral tekshirishlar olib boriladi. Oraliq optronlarda asosan manba sifatida yorug‘lik diodlari (SD) ishlatiladi. Ba’zi yorug‘lik diodlari uchun nurlanish amplitudasining spektri 2-rasmda ko‘rsatilgan.

Spektrga mos fotopriemnik tanlanib optojuftlik yig‘iladi. Qurilmaning ishlatilishi joyiga qarab, yorug‘lik diodi kristall-diskret ko‘rinishida yig‘ilganlari turg‘un ishchi xolat uchun ishlatiladi. Fotopriyomniklar ham shungga mos loyihalari tanlanadi. Mikroelektron variantdagi optronlar yupqa pardali ko‘rinishda loyihalanadi.[3]. Bunday optronlar, mikrominiatyur o‘lchamlar zarurati bor sohalarda (Masalan kosmik texnika) ishlatiladi. (3,4-rasmlar).

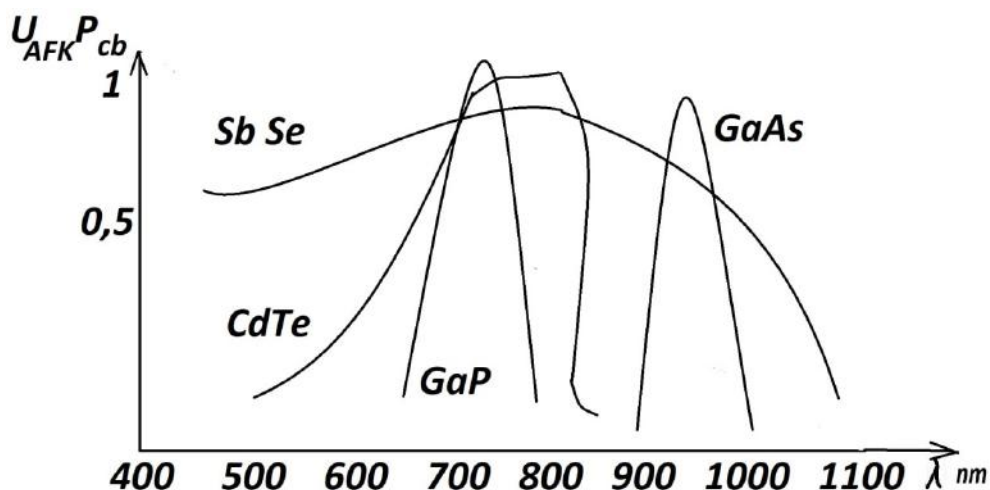


3-rasm Kristall svetodiod kadmiy va surma.



4-rasm Yupqa yassi pardali elektriyuminessen yacheyka.

Xalkogenidlari negizida loyihalangan optron juftliklarining (SdTe-GaAs va $\text{Sb}_2\text{Se}_3\text{-GaP}$) spektral bog'lanishlari quyidagi rasmda ifodalangan: (5-rasm)



5-rasm optron juftliklarining spektral bog'lanishlari

NATIJA VA MUHOKAMA

Optoelektron qurilmaning samaradorli yuqoridagilar bilan bir qatorda, elementar optron elementlari (yorug'lik manbasi va uning iste'molchisi) orasidagi optik foton vositasidagi bog'lanishlardagi yorug'lik signallarining kam yo'qotishlar bilan buzilmay foto qabul qilgichga yetib kelishi bilan bog'liq. Mikroelektron tizimda ham bu muammoni tolali optika vositasida amalga oshirish mumkin. Tolali optika qurilmalari ixcham, uning yorug'lik tolasi diametri 1 mkm atrofida bo'ladi. Elastikligi yuqori, uning egilishi uzatilayotgan optik signalni buzmaydi. Samaradorligi elektr aloqa vositasidan juda yuqori. Tasvir uzatish imkoniyatining darajasi yuqori. Bu afzalliklarni amalga oshirish uchun optik tola bilan manba va yorug'lik iste'molchisi orasidagi optik kontakt sifati yuqori

ILMIY AXBOROT

bo'lishi kerak. Bu vazifani qoniqarli darajada amalga oshirish uchun immersion muxit sifatida sindirish ko'rsatkichi (n) yorug'lik manbasi va fotopriyomnik sindirish ko'rsatkichiga yaqin bo'lishi kerak. Yuqori sindirish ko'rsatkichli materialdan optik tola yasash, kontakt sifatini ta'minlash to'la ichki qaytish burchagini ortiradi va yorug'lik qaytishi bilan bog'liq optik (foton) yo'qotishlarni kamaytiradi. Bunday optik tola materialli sifatida selenli oyna ($n=1.8 \pm 1.9$) dan foydalanish mumkin.[4] Yorug'lik manbasi va fotopriyomnik materialidagi generatsiya-rekombinatsiya jarayonlari bilan bog'liq optik yo'qotishlar ham optron samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday salbiy oqibatlarining dastlabki darajasini baholash maqsadida manba geterokontaktlaridagi potensial o'zgarishlarning-potensial diagrammasidan foydalaniladi (zona diagramma).

XULOSA

Xalkogenid yupqa yarimo'tkazgich pardalari olish va ular negizida yuqori samarador generator tipidagi fotopriyomniklar yaratish asoslari takomillashtirilgan. Spektral bog'lanishlarni tadqiq qilish bilan optimal optron juftlik yaratish mumkinligi aniqlangan. Ulkan yoritgich (Quyosh) vositasida mitti yoritgichdan foydalanib mikroelektron optronlar yaratish asoslari bayon qilingan. Optron samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsata oladigan omillar aniqlangan. Ulkan va mitti yoritgichlarning birgalikda ishlashini ta'minlovchi optoelektrik qurilma yaratish mumkinligi isbotlangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Найманбаев Р., Ирматов С. Яримўтказгичли фотоприёмниклар // Монография. «Фарғона нашриёти». 2011, 62-64-б.
2. Рахимов Н.Р., Ушаков О.К. Оптоэлектронные датчики на основы АФК-эффекта // Новосибирск, изд. «СГГА». 2010, с.86-92
3. Naymanbayev R., Toxirov M.Q., Nurdinova R.A., Sobirova S.S., Xomidov A.Q. On the Nature of the APV Effect in Semiconductor Copper and Indium Telluride Films // Uzbek Journal of Physics. 2012, Vol 14, p.311-315
4. Onarkulov, K. E., Naymonboyev, R., Yuldashev Sh, A., & Yuldashev, A. A. (2021). Preparation of photo elements from chalcogenide thin curtains. *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training*, 7(2).
5. Onarkulov, M., Nasriddinov, S., Yuldashev, S., & Yunusaliev, L. (2020). TECHNOLOGICAL FEATURES OF OBTAINING STRENGTH SENSITIVE POLYCRYSTALLINE FILMS Bi₂-XSbXTe₃. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(3), 27.
6. Onarkulov, K. E., Naymanbayev, R., Yuldashev, A. A., & Yuldashev Sh, A. (2021). Халкогенид бирикмалари устида тадқиқотлар. *Eurasian journal of academic research*, 1(6), 136-137.
7. Онарқулов, К. Э., Юлдашев, Ш. А., & Юлдашев, А. А. (2022). ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЙ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 427-434.
8. Egamberdievich, O. K., Abrorovich, Y. S., Abdvositovich, Y. A., & Qizi, Y. S. A. (2022). Determination of Microparameters of Halcogenide Thin Movies. *Journal of Optoelectronics Laser*, 41(5), 523-530.
9. Онарқулов, К., & Юлдашев, А. (2017). ВИСМУТ-СУРМА ТЕЛЛУРИД ЮПҚА ПАРДАЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХОССАЛАРИГА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИНГ ТАЪСИРИ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (2), 2-2.
10. Yuldashev, A. (2022). ОПТОТРАНСФОРМАТОР. *Science and innovation*, 1(A7), 876-882.
11. Onarkulov, M., & Gaynazarova, K. (2024, March). Effect of chalcogens on Bi-Sb (Se-Te) based alloys made under inert gas pressure. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.